



— 次世代パワーデバイスを使いこなせ！ —

高速デバイスを操る回路設計・周辺技術・応用

◇ 日時 : 2021 年 5 月 27 日(木)9:55~16:50

◇ 場所 : オンライン開催

SiC や GaN などの新ワイドバンドギャップパワー半導体は、もはや、もの珍しい高価なデバイスではなくなった。エアコンに代表される家電製品や PC 等の情報機器、自動車や鉄道、各種産業動力機器の内部に静かに入り込んでいる。しかし、Si 半導体デバイスに比べ性能が優れているが故に、その取扱いについてはこれまでにない制御も必要になってくる。

本研究会では新材料半導体の普及に関して各応用分野から最新情報を解説するほか、新材料半導体を持つ高速スイッチングや高パワー密度を制御する技術について広く(デバイス、実装、回路、材料、評価・解析技術)議論する。

.....プログラム.....

- | | |
|--|---------------------|
| 1. 開会の挨拶 | 9:55~10:00 |
| | 中村 孝 (世話人代表) |
| 2. 「アクティブゲート技術による車載 SiC-MOSFET の低損失化」 | 10:00~10:30 |
| | 秋山 博則 (デンソー) |
| 3. 「超高速 GaN パワー半導体応用におけるノイズ発生
メカニズムと高速スイッチングに起因するノイズの効果的な抑制法」 | 10:30~11:00 |
| | 山本 真義 (名古屋大学) |
| 4. 「次世代電力システムを支えるパワーエレクトロクスと
パワーデバイスへの期待」 | 11:00~11:30 |
| | 中島 達人 (東京都市大学) |
| 5. 「社会インフラシステム向けSiC適用変換器の開発」 | 11:30~12:00 |
| | 葛巻 淳彦 (東芝インフラシステムズ) |

※都合により葛巻氏の講演は中止となりました。申し訳ございません。

昼休み (12:00~13:20)

- | | |
|---|------------------|
| 8. 「高パワー密度を実現するアクティブパワーデカップリング技術」 | 13:20~13:50 |
| | 伊東 淳一 (長岡技術科学大学) |
| 9. 「パワーサイクル試験や熱評価での働き方改革」 | 13:50~14:20 |
| | 原 智章 (シーメンス株式会社) |
| 10. 「Si-CR スナバを内蔵した両面冷却
SiC パワーモジュールのスイッチング評価」 | 14:20~15:10 |
| | 畑 遼太郎 (村田製作所) |

コーヒーブレイク (15:10~15:50)

11. 「炭化珪素アバランシェダイオードによる
スイッチング時のサージ抑制」 山本 真幸 (産総研・山梨大学) 15:50~16:20

12. 特別講演 16:20~16:50

“Design of integrated WBG power electronics” Alberto Castellazzi (京都先端科学大学)

14. 閉会の挨拶 16:50~17:00

須田 淳 (分科会幹事長)

.....
■ 広告受付: 予稿集広告は1ページ4,000円。

申し込みは <https://annex.jsap.or.jp/limesurvey/index.php/672919/lang-ja> から【締切:5月17日(月)】

■ 参加登録: <https://annex.jsap.or.jp/limesurvey/index.php/743334/lang-ja> から参加登録をお願いします。
*最新の開催案内は <https://annex.jsap.or.jp/adps/>

■ 参加費: (予稿集(電子版)・消費税込) Web決済にてお支払いください。

先進パワー半導体分科会会員 * 4,000円、分科会学生会員 1,000円、一般 6,000円、一般学生 1,000円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

問合せ先:

白石 陽子 (応用物理学会事務局) TEL: 03-3828-7723, e-mail: shiraishi@jsap.or.jp

参加申込 QRコード

